


Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета ИФФВТ
от 16 июня 2020 г. протокол № 11/02-19-10
Председатель _____ (Хусаинов А.Ш.)
(подпись, расшифровка подписи)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	Физика активных элементов
Факультет	Инженерно-физический факультет высоких технологий
Кафедра	Радиофизики и электроники
Курс	3

Направление (специальность) **03.03.03 Радиофизика**
код направления (специальности), полное наименование

Направленность (профиль/специализация) **Твердотельная электроника и наноэлектроника**
полное наименование

Форма обучения **очная**
очная, заочная, очно-заочная (указать только те, которые реализуются)

Дата введения в учебный процесс УлГУ: 1 сентября 2020 г.

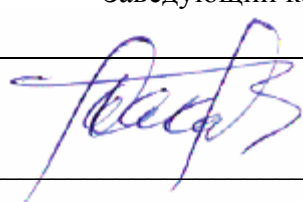
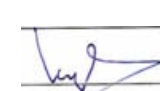
Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.


Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание
Вострецова Л.Н.	ИФ	к.ф.-м.н.

СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой ИФ	Заведующий выпускающей кафедрой (кафедра РФЭ)
 /С.Б. Бакланов/	 / Гурин Н.Т./
09 июня 2020 г.	Подпись _____ ФИО _____ « 09 » 06 2020 г.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Целью дисциплины является изучение активных элементов радиоэлектроники, их моделей, областей и особенностей использования в радиоэлектронных системах.

Задачи дисциплины:


- Достигнуть понимания принципов работы активных элементов радиоэлектроники.
- Дать информацию об основных эксплуатационных характеристиках, параметрах и схемах включения активных элементов.
- Познакомить с моделями элементов для использования в компьютерных технологиях проектирования радиоэлектронных систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП. Данная дисциплина формирует навыки измерения и анализа входных и выходных характеристик полупроводниковых приборов. «Физика активных элементов» базируется на основах физики, знании физики конденсированного состояния вещества, зонной теории и физики полупроводниковых структур, способов создания $p-n$ -переходов. Она читается в 5-ом семестре 3-ого курса и основывается на следующих входных знаниях, умениях, навыках и компетенциях студента, полученных им при изучении предшествующих дисциплин:

- Математический анализ
- Аналитическая геометрия
- Механика
- Научные основы школьного курса физики
- Математический анализ функций многих переменных
- Молекулярная физика
- Линейная алгебра
- Векторный и тензорный анализ
- Электричество и магнетизм
- Теория вероятностей и математическая статистика
- Дифференциальные уравнения
- Основы радиоизмерений
- Проектная деятельность
- Методы математической физики
- Интегральные уравнения и вариационное исчисление
- Колебания и волны, оптика
- Распространение электромагнитных волн в однородных, периодических и наноструктурах
- Численные методы в квантовой оптике
- Микропроцессорные системы
- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности


Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие «входные» знания, умения, навыки и компетенции:

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

- Владеть техникой дифференцирования функций одной переменной
- применять правило дифференцирования сложной функции, метод логарифмического дифференцирования,
- дифференцировать параметрически и неявно заданные функции,
- находить производные высших порядков; техникой интегрирования элементарных функций;
- владеть техникой дифференцирования функций нескольких переменных
- применять правило дифференцирования сложной функции, дифференцировать параметрически и неявно заданные функции,
- находить дифференциалы высших порядков
- уметь использовать основные программные средства, пользоваться глобальными информационными ресурсами,
- знать основные законы механики и кинематики материальной точки
- знать основные законы электромагнитного взаимодействия, включая уравнения Максвелла
- использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач
- Знать базовые профессиональные понятия и определения, с которыми он будет сталкиваться в ходе обучения

Данная дисциплина является предшествующей для будущего изучения следующих специальных дисциплин:

- Теоретические основы электротехники
- Электродинамика СВЧ
- Электродинамика
- Теория колебаний
- Физическая электроника
- Полупроводниковая электроника
- Радиоэлектроника
- Квантовая механика
- Микро- и наноэлектроника
- Автоматизация эксперимента
- Микро- и наносхемотехника
- Интегральная и волоконная оптика
- Квантовая электроника
- Практикум по квантовой электронике
- Практикум по электронике
- Оптоэлектронные устройства
- Оптические направляющие среды и пассивные компоненты ВОЛС
- СВЧ полупроводниковые приборы и методы автоматизированного контроля электропараметров СВЧ-модулей
- Термодинамика и статистическая физика
- Конструкции гибридных интегральных схем и микросборок
- Статистическая радиофизика и нанооптика

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		


- Практикум по интегральной и волоконной оптике
- Преддипломная практика
- Научно-исследовательская работа

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью к овладению базовыми знаниями в области математики и естественных наук, их использованию в профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2);
- способностью понимать принципы работы и методы эксплуатации современной радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования (ПК-1).

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ОПК - 1 - способность к овладению базовыми знаниями в области математики и естественных наук, их использованию в профессиональной деятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зонную теорию полупроводников • статистику электронов и дырок в классических полупроводниках и полупроводниках с нановключениями <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • строить зонную диаграмму р-п-перехода, барьера Шоттки • рассчитывать концентрации носителей заряда в областях полупроводникового прибора <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способами расчета характеристик полупроводниковых структур, исходя из знаний материала полупроводника и уровня его легирования
ОПК-2 - способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • основные способы самостоятельного получения новых знаний, информации относительно полупроводниковых структур с нановключениями. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • самостоятельно приобретать новые знания с использованием современных образовательных и информационных технологий. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками самостоятельного приобретения новых знаний, методами научного познания

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		


ПК - 1 - способность понимать принципы работы и методы эксплуатации современной радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> физические принципы работы контакта металл-полупроводник и р-n-перехода (диод), биполярных и полевых транзисторов, оптоэлектронных приборов <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> из вольтамперной и вольтфарадной характеристик точечного диода определять контактную разность потенциалов, а также степень легирования полупроводника, определять тип пробоя по температурной зависимости изменения напряжения стабилизации <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> навыками измерения статических вольтамперных характеристик транзистора и их зависимости от распределения концентрации неосновных носителей в базе транзистора, расчета различных физических характеристик полупроводникового диода, биполярного и полевого транзисторов
---	---

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) 4 ЗЕ

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах) 144 ч


Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения очная)			
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам		
		4	5	6
1	2	3	4	5
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	54		54	
Аудиторные занятия:				
лекции	18		18	
Семинары и практические занятия				
Лабораторные работы, практикумы	36		36	
Самостоятельная работа	54		54	
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум,	Тестирование, контрольная работа		Тестирование, контрольная работа	

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

рефераты др.(не менее 2 видов)				
Курсовая работа	-		-	
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	Экзамен (36)		Экзамен (36)	
Всего часов по дисциплине	144		144	

4.3. Содержание дисциплины (модуля.) Распределение часов по темам и видам учебной работы:
Форма обучения очная

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	8
Тема 1. Основы зонной теории полупроводников	18	2		4	2	10	тестирование
Тема 2. Основы статистики носителей заряда в полупроводниках	8	2		2	2	6	Тестирование, контрольная работа
Тема 3. Диоды с контактом металл-полупроводник	18	2		6	2	10	Тестирование, контрольная работа
Тема 4. Полупроводниковые диоды	18	2		6	2	10	Тестирование, контрольная работа
Тема 5. Лавинно-пролетные диоды.	8	2	-	-		6	тестирование
Тема 6. Полевые транзисторы, управляемые р-п-переходом	14	2	-	8	2	6	тестирование
Тема 7. Биполярные транзисторы	14	2		8	2	6	Тестирование, контрольная работа
Тема 8. МДП-	12	2		8	2	4	тестирова

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

транзисторы.							ние
Тема 9. Оптоэлектронные п/п приборы	12	2		-	2	4	тестирова ние
8. Экзамен	36						тестирова ние
ИТОГО	144	18		36	12	54	тестирова ние

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Тема 1. Основы зонной теории полупроводников

Основные положения зонной теории. Волновая функция электрона в периодическом поле кристалла. Функции Блоха. Зоны Брюллюэна. Энергетические зоны – запрещенные и разрешенные. Модель Кроннига-Пенни. Закон дисперсии, эффективная масса. Зонная структура металлов полупроводников.

Тема 2. Основы статистики носителей заряда в полупроводниках

Распределение квантовых состояний в зонах. Распределение Ферми-Дирака. Концентрация электронов и дырок в зонах. Невырожденные полупроводники. Собственная концентрация носителей заряда.

Тема 3. Диоды с контактом металл-полупроводник.


Зонные диаграммы контактов металл-полупроводник. Запорный и антизапорные слои. Распределение поля и потенциала в обедненном слое (Барьер Шоттки). Ширина обедненного слоя в тепловом равновесии и при наличии смещения. Вольтамперные характеристики диодов с контактом Шоттки. Высота барьера в реальных контактах металл-кремний, силицид кремний-кремний, металл-арсенид галлия. Омический контакт.

Тема 4. Полупроводниковые диоды.

Образование р-п- перехода, контактная разность потенциалов. Зонная диаграмма р-п- перехода в тепловом равновесии. Распределение поля, потенциала и ширина резкого и плавного р-п- переходов в тепловом равновесии. Зонные диаграммы р-п- переходов при прямом и обратном смещениях. Ширина резкого и плавного р-п- перехода при смещениях. Вольт-емкостная характеристика. Диодная теория выпрямления р-п- перехода в диффузионном приближении. Диод с короткой базой. Рекомбинационные процессы в р-п- переходах. Влияние различных факторов на величину рекомбинационного тока. Работа р-п- перехода при большом уровне инжекции. Механизм Холла. Влияние сопротивления базы. Механизм инжекционного усиления в диодах с длинной базой. Магнитодиоды. Проводимость диода с р-п- переходом на малом переменном сигнале, мало-сигнальная эквивалентная схема. Диффузионная емкость, зависимость от частоты переменного сигнала. Переходные процессы в диодах при включении из прямого направления в обратное и из прямого в нейтральное.

Тема 5. Лавинно-пролетные диоды.

Лавинно-пролетный режим работы и режим с захваченной плазмой. р-і-п- диоды. Виды пробоя р-п- перехода: тепловой, туннельный, лавинный. Коэффициенты ионизации электронов и дырок, критерий лавинного пробоя, коэффициенты умножения электронов и дырок. Соотношения для зависимости напряжения лавинного пробоя резкого р-п- перехода от концентрации примесей. Туннельные и обращенные диоды. Особенности вольтамперных характеристик. Влияние электрон-фононного взаимодействия на туннельные процессы. Механизмы переноса тока в диэлектриках. Токи, ограниченные

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

пространственным зарядом.

Тема 6. Полевые транзисторы, управляемые р-n- переходом.

Полевые транзисторы с управляющим р-n- переходом. Принцип действия. Расчет входных вольтамперных характеристик полевого транзистора с управляющим р-n- переходом. Много и мало сигнальные параметры. Частотные свойства транзисторов с управляющим р-n- переходом. Транзисторы со статической индукцией.

Тема 7. Биполярные транзисторы.

Режим работы: нормальный активный режим, инверсный активный режим, режим насыщения, режим отсечки. Транзистор как усилитель мощности. Схемы включения с общей базой и общим эмиттером. Зонная диаграмма транзистора в нормальном активном режиме. Бездрейфовый и дрейфовый транзисторы. Образование встроенного поля на базе планарного и мезапланарного транзисторов. Входные и выходные данные вольтамперные характеристики. Интегральные параметры - коэффициент переноса базы, коэффициент инжекции эмиттера, коэффициенты передачи тока в схемах с ОБ и ОЭ. Зависимости от частоты малосигнальных коэффициентов передачи тока, предельная частота коэффициента передачи тока и граничная частота усиления. Влияние встроенного поля в базе и барьерной емкости эмиттер-база на частоты. Эффект вытеснения эмиттерного тока к краям эмиттеров. Особенности лавинного пробоя - тепловой и токовой. Переходные процессы в транзисторном ключе. Шумовые свойства биполярных транзисторов. Разновидность биполярных транзисторов, используемых в интегральных микросхемах: многоэмиттерный транзистор, многоколлекторный транзистор, горизонтальный транзистор, переключающий транзистор с барьером Шоттки. Биполярные транзисторы с гетеропереходами и вариозонной базой.

Тема 8. МДП-транзисторы.

Полевые транзисторы с изолированным затвором (МДП-транзисторы). МДП-транзисторы с встроенным и индуцированным каналами. Расчет входных вольтамперных характеристик МДП-транзисторов на крутых и пологих участках. Малосигнальные параметры. Частотные свойства МДП-транзисторов. Мощные МДП-транзисторы. Особенности применения МДП-транзисторов в БИС. Эффекты короткого и узкого канала. Горячие носители в канале.

Тема 9. Оптоэлектронные п/п приборы.


Фоторезисторы. Светоизлучающие диоды, п/п инжекционные лазеры. Электролюминесцентные излучатели. Принцип действия, основные характеристики и параметры. Фотодиоды на основе диодов с р-n- переходом, контакта металл-полупроводник, гетероперехода, интегральная чувствительность и спектральная характеристика. Фотоэлементы и солнечные батареи с р-n- переходом. Вольтамперные характеристики, коэффициент полезного действия, световая характеристика. Биполярные, МДП- фототранзисторы и фототиристоры.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Не предусмотрено учебным планом

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ

Лабораторная работа 1. Исследование электрических характеристик контакта металл-полупроводник

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Цель работы: Изучение принципа работы диодов Шоттки, измерение и анализ вольт-амперных характеристик (ВАХ) и вольт-фарадных характеристик (ВФХ), определение основных параметров диодов.

Лабораторная работа 2. Температурная зависимость параметров полупроводниковых диодов

Цель работы – установление соответствия между реальными и теоретическими температурными характеристиками различных полупроводниковых диодов и их взаимосвязи с параметрами полупроводниковых материалов. Содержанием работы является исследование зависимости статических ВАХ диодов от температуры окружающей среды. В работе снимаются температурные зависимости обратных токов и прямых напряжений диодов, изготовленных из разных материалов, и определяются

Лабораторная работа 3. Исследование полупроводниковых диодов

Цель работы – исследование прямых и обратных вольт-амперных характеристик кремниевого и германиевого диода; исследование сопротивления диода при прямом и обратном включении; определение напряжения изгиба вольт-амперной характеристики.

Лабораторная работа 4. Определение статических параметров модели эберса–мола по вольт-амперным характеристикам биполярного транзистора

Цель работы – измерение статических ВАХ биполярного транзистора (БТ) и определение по ним статических параметров инжекционной модели Эберса–Молла (Э–М) для БТ. В работе снимаются входные, выходные и передаточные характеристики БТ в схеме с ОЭ. По передаточным характеристикам для режимов нормального и инверсного включения определяются соответствующие коэффициенты передачи тока. Для нахождения остальных параметров модели Э–М измеряются нормальные и инверсные входные характеристики БТ для схемы с ОБ в режиме холостого хода (при обрыве третьего электрода). По полученным характеристикам определяются значения

Лабораторная работа 5. Исследование статических характеристик и дифференциальных параметров ПТУП


Цель работы – ознакомиться с ВАХ и основными дифференциальными статическими параметрами полевых транзисторов с управляющим затвором в виде р-п-перехода – ПТУП.

В работе снимаются основные ВАХ ПТУП (передаточные и выходные) и по результатам измерений определяются статические дифференциальные параметры ПТУП: крутизна, выходная проводимость, внутреннее сопротивление и коэффициент усиления по напряжению.

Лабораторная работа 6. Исследование статических характеристик и дифференциальных параметров МОП-транзистора

Цель работы – ознакомиться с ВАХ и основными дифференциальными статическими параметрами полевых транзисторов с изолированным затвором (МДП-транзисторов). В англоязычной литературе для них чаще всего используется сокращение MOSFET – Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor.

В работе измеряется пороговое напряжение МОПТ, его передаточные и выходные вольт-амперные характеристики, и по результатам измерений определяются статические дифференциальные параметры

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Лабораторная работа 7. Исследование излучательных характеристик светодиодов


Цель работы Ознакомление с устройством и функционированием полупроводниковых светодиодов, изучение их основных излучательных характеристик и особенностей работы с аппаратурой для измерения мощности оптического излучения

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Зонная теория. Одночастичное приближение
2. Зонная теория. Волновая функция электрона в периодическом поле кристалла
3. Функции Блоха
4. Зоны Брюллюэна
5. Зонная теория. Модель Кронига-Пенни
6. Закон дисперсии. Эффективная масса носителей заряда
7. Плотность состояний в разрешенных зонах объемного полупроводника
8. Функция Ферми – Дирака. Уровень Ферми
9. Концентрация электронов и дырок в разрешенных зонах собственного полупроводника
10. Собственная концентрация носителей заряда
11. Положение уровня Ферми в собственном полупроводнике
12. Положение уровня Ферми в легированном невырожденном полупроводнике
13. Зонная диаграмма контакта металл-полупроводник. Условие возникновения барьера
14. Вольтамперные характеристики диодов с контактом Шоттки.
15. Полупроводниковые диоды. Образование р-п- перехода, контрактная разность потенциалов. Зонная диаграмма р-п- перехода в тепловом равновесии.
16. Распределение поля и потенциала в обедненном слое, ширина обедненного слоя в тепловом равновесии и при наличии смещения для резкого р-п-перехода
17. Распределение поля и потенциала в обедненном слое, ширина обедненного слоя в тепловом равновесии и при наличии смещения для плавного р-п-перехода
18. Диодная теория выпрямления р-п-перехода в диффузном приближении. Диод с длинной базой.
19. Диодная теория выпрямления р-п-перехода в диффузном приближении. Диод с короткой базой.
20. Вольт-емкостная характеристика резкого р-п-перехода
21. Вольт-емкостная характеристика плавного р-п-перехода
22. Мало-сигнальная эквивалентная схема диода на основе р-п-перехода
23. Лавинно- пролетные диоды. Лавинно-пролетный режим работы.
24. Лавинно- пролетные диоды. Режим с захваченной плазмой.
25. р-і-п- диоды.
26. Принцип работы полевого транзистора с управляющим р-п-переходом
27. Передаточная вольт-амперная характеристика полевого транзистора с управляющим р-п-переходом
28. Выходная вольт-амперная характеристика полевого транзистора с управляющим р-п-переходом

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		


29. Биполярный транзистор. Принцип работы: коэффициент инжекции и коэффициент рекомбинации
30. Биполярный транзистор. Режимы работы
31. Биполярный транзистор. Входные и выходные характеристики в схеме с общей базой
32. Биполярный транзистор. Входные и выходные характеристики в схеме с общим эмиттером
33. Биполярный транзистор. Число Гуммеля
34. Биполярный транзистор. h-параметры
35. Биполярный транзистор. Физические параметры
36. Полевые транзисторы с изолированным затвором(МДП- транзисторы).
37. МДП- транзисторы с встроенным и индуцированным каналами.
38. МДП – транзисторы. Выходные характеристики
39. МДП- транзисторы. Передаточные характеристики
40. Расчет входных вольтамперных характеристик МДП-транзисторов на крутых и пологих участках.
41. Принцип работы фоторезистора
42. Принцип работы фотодиода
43. Принцип работы фототранзистора
44. Принцип работы светодиода

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание, требования, условия и порядок организации самостоятельной работы обучающихся с учетом формы обучения определяются в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы обучающихся», утвержденным Ученым советом УлГУ (протокол №8/268 от 26.03.2019г.).

Форма обучения очная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.)	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
Тема 1. Основы зонной теории полупроводников	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена, письменный ответ на вопросы	10	Проверка домашнего задания
Тема 2. Основы статистики носителей заряда в полупроводниках	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена, письменный ответ на вопросы	6	Проверка домашнего задания
Тема 3. Диоды с контактом металл-полупроводник	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена, решение задач	10	Проверка домашнего задания
Тема 4. Полупроводниковые диоды	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена, решение задач	10	Проверка домашнего задания
Тема 5. Лавинно-пролетные диоды.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена, решение задач	6	Проверка домашнего задания

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Тема 6. Полевые транзисторы, управляемые р-п-переходом	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена, решение задач	6	Проверка домашнего задания
Тема 7. Биполярные транзисторы	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена, решение задач	6	Проверка домашнего задания
Тема 8. МДП-транзисторы.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена, решение задач	4	Проверка домашнего задания
Тема 9. Оптоэлектронные п/п приборы	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена, письменный ответ на вопросы	4	Проверка домашнего задания
Экзамен	Подготовка к сдаче экзамена: проработка вопросов и прорешивание типовых задач	36	экзамен

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Список рекомендуемой литературы

основная


1. Старосельский, В. И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники : учебное пособие для вузов / В. И. Старосельский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 463 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-0808-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/425163>
2. Червяков, Г. Г. Электронная техника : учебное пособие для академического бакалавриата / Г. Г. Червяков, С. Г. Прохоров, О. В. Шиндор. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10000-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/429122>

дополнительная:

1. Шишкин, Г. Г. Электроника : учебник для бакалавров / Г. Г. Шишкин, А. Г. Шишкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 703 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3391-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/425494>

учебно-методическая:

1. Вострецова Л. Н. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Физика активных элементов» для студентов специальности 03.03.03 «Радиофизика» / Л. Н. Вострецова; УлГУ, ИФФВТ, Каф. инж. физики. - Ульяновск : УлГУ, 2019. –Режим доступа: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/7177>
2. Физика полупроводниковых приборов : учебное пособие / Д. Я. Вострецов, Л. Н. Вострецова, Д. А. Богданова [и др.]; УлГУ, ИФФВТ, Каф. инженерной физики. - Ульяновск : УлГУ, 2019. – Режим доступа:

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Изображение : электронные.

6. Федеральные информационно-образовательные порталы:

6.1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. – URL: <http://window.edu.ru/>. – Текст : электронный.

6.2. Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.

7. Образовательные ресурсы УлГУ:

7.1. Электронная библиотека УлГУ : модуль АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

7.2. Образовательный портал УлГУ. – URL: <http://edu.ulsu.ru>. – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный.

Согласовано:

Зам. нач. ИТ

Должность сотрудника УИТиТ

Ключкова М.А.

ФИО

Т.В.Ш.

подпись

дата


12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аудитории для проведения лекций, семинарских занятий, для выполнения лабораторных работ и практикумов, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для предоставления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-библиотечной системе. При проведении лабораторных работ используется следующее оборудование:

- Программно-управляемый источник питания РРЕ3323
- Вольтметр В7-46
- Шаговый двигатель
- Вольтметр В7-40
- Генератор низкой частоты ГЗ-118
- Частотомер ЧЗ-63
- Вольтметр ВЗ-38Б
- Генератор ГЗ-123
- Осциллограф С1-159
- Вольтметр В7-27
- Испытатель Л2-54
- Генератор ГЗ-36
- Блок питания БП-03
- Генератор импульсов Г5-63
- Осциллограф С1-64а
- Вольтметр В7-16

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

- Блок питания SH 01012
- Камера измерительная
- МДП структура
- Вольтметр В7-16а
- Измеритель емкости Е7-12
- Блок питания БП – 15
- Монохроматор МУМ
- Вольтметр В7-16а
- Осветитель

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

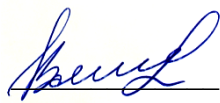
– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей

Разработчик



подпись

к.ф.-м.н., доцент кафедры ИФ Вострецова Л.Н.

должность

ФИО